Berichtigung

Zum Beitrag R. Mahnkopf, G. Przyrembel und H. G. Wagemann: "Characterization of hot carrier degradation within the gate oxide of short channel MOSFET's"

Die Formel 10 muß richtig lauten:

$$\begin{aligned}
 \frac{d \Delta N_{ot}(t, T)}{dt} &= k_1(T) \cdot \Delta N_{ot}(t, T) \\
 &\quad + k_2(T) \cdot \Delta N_{ot}(t, T) \\
 + \frac{d \Delta N_{it}(t, T)}{dt} &= k_2(T) \cdot \Delta N_{ot}(t, T) \\
 k_{1,2}(T) &= k_{1,2_0} \cdot \exp \left(-\frac{W_{1,2}}{k_B T} \right)
 \end{aligned} \tag{10}$$

Arch. Elektrotech. 74 (1991), 379–387